

# シングル N チャンネル MOSFET

ELM17408GA-S

<http://www.elm-tech.com>

## ■概要

ELM17408GA-S は低入力容量、低電圧駆動、低 ON 抵抗という特性を備えた大電流 MOS FET です。

## ■特長

- ・  $V_{ds}=20V$
- ・  $I_d=2.2A$  ( $V_{gs}=4.5V$ )
- ・  $R_{ds(on)} < 82m\Omega$  ( $V_{gs}=4.5V$ )
- ・  $R_{ds(on)} < 95m\Omega$  ( $V_{gs}=2.5V$ )
- ・  $R_{ds(on)} < 120m\Omega$  ( $V_{gs}=1.8V$ )

## ■絶対最大定格値

特に指定なき場合、 $T_a=25^\circ C$

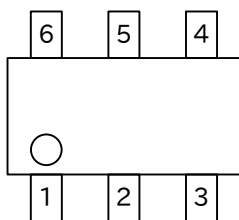
項目	記号	規格値	単位	備考	
ドレイン - ソース電圧	$V_{ds}$	20	V		
ゲート - ソース電圧	$V_{gs}$	$\pm 8$	V		
連続ドレイン電流	$I_d$	$T_a=25^\circ C$	2.20	A	1
		$T_a=70^\circ C$	1.75		
パルス・ドレイン電流	$I_{dm}$	10	A	2	
最大許容損失	$P_d$	$T_c=25^\circ C$	0.625	W	1
		$T_c=70^\circ C$	0.400		
接合温度範囲及び保存温度範囲	$T_j, T_{stg}$	- 55 ~ 150	$^\circ C$		

## ■熱特性

項目	記号	Typ.	Max.	単位	備考
最大接合部 - 周囲温度	$R_{\theta ja}$	160	200	$^\circ C/W$	1
最大接合部 - 周囲温度		定常状態	180	220	
最大接合部 - リード	$R_{\theta jl}$	130	160	$^\circ C/W$	3

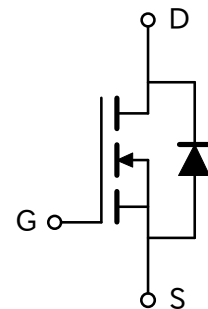
## ■端子配列図

SC-70-6(TOP VIEW)



端子番号	端子記号
1	DRAIN
2	DRAIN
3	GATE
4	SOURCE
5	DRAIN
6	DRAIN

## ■回路



# シングル N チャンネル MOSFET

ELM17408GA-S

<http://www.elm-tech.com>

## ■ 電気的特性

特に指定なき場合、 $T_a=25^\circ\text{C}$

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	
静的特性							
ドレイン・ソース降伏電圧	BVdss	$I_d=250\mu\text{A}$ , $V_{gs}=0\text{V}$	20			V	
ゼロ・ゲート電圧ドレイン電流	$I_{dss}$	$V_{ds}=16\text{V}$ , $V_{gs}=0\text{V}$			1	$\mu\text{A}$	
					$T_a=55^\circ\text{C}$		5
ゲート漏れ電流	$I_{gss}$	$V_{ds}=0\text{V}$ , $V_{gs}=\pm 8\text{V}$			100	nA	
ゲート・スレッシュホールド電圧	$V_{gs(th)}$	$V_{ds}=V_{gs}$ , $I_d=250\mu\text{A}$	0.4	0.6	0.8	V	
オン状態ドレイン電流	$I_d(on)$	$V_{gs}=4.5\text{V}$ , $V_{ds}=5\text{V}$	10			A	
ドレイン・ソースオン状態抵抗	$R_{ds(on)}$	$V_{gs}=4.5\text{V}$ $I_d=2.2\text{A}$	$T_a=125^\circ\text{C}$		67	82	m $\Omega$
					99	125	
				$V_{gs}=2.5\text{V}$ , $I_d=2\text{A}$	78	95	
				$V_{gs}=1.8\text{V}$ , $I_d=1\text{A}$	96	120	
順方向相互コンダクタンス	Gfs	$V_{ds}=5\text{V}$ , $I_d=1.6\text{A}$		6.7		S	
ダイオード順方向電圧	Vsd	$I_s=1\text{A}$ , $V_{gs}=0\text{V}$		0.69	1.00	V	
最大寄生ダイオード連続電流	$I_s$				0.91	A	
動的特性							
入力容量	Ciss			499		pF	
出力容量	Coss	$V_{gs}=0\text{V}$ , $V_{ds}=10\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$		65		pF	
帰還容量	Crss			56		pF	
ゲート抵抗	Rg	$V_{gs}=0\text{V}$ , $V_{ds}=0\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$		3		$\Omega$	
スイッチング特性							
総ゲート電荷	Qg	$V_{gs}=4.5\text{V}$ , $V_{ds}=10\text{V}$ $I_d=2.2\text{A}$		6.02		nC	
ゲート・ソース電荷	Qgs			0.41		nC	
ゲート・ドレイン電荷	Qgd			1.35		nC	
ターン・オン遅延時間	td(on)	$V_{gs}=5\text{V}$ , $V_{ds}=10\text{V}$ $R_L=4.5\Omega$ , $R_{gen}=6\Omega$		6.5		ns	
ターン・オン立ち上がり時間	tr			8.0		ns	
ターン・オフ遅延時間	td(off)			61.0		ns	
ターン・オフ立ち下がり時間	tf			16.0		ns	
寄生ダイオード逆回復時間	trr	$I_f=2.2\text{A}$ , $dI_f/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		23.2		ns	
寄生ダイオード逆回復電荷量	Qrr	$I_f=2.2\text{A}$ , $dI_f/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		8.6		nC	

備考：

- $R_{\theta ja}$  の値は  $T_a=25^\circ\text{C}$ 、2 オンス銅箔付き FR-4 基板上にマウントされた装置を使用して測定されています。またアプリケーションに付与される値は使用者のボードデザインに依存し、電流定格は  $t \leq 10\text{s}$  の熱抵抗定格に基づいています。
- 接合部温度は反復定格及びパルス幅を制限します。
- $R_{\theta ja}$  は接合部 - リード間と接合部 - 周囲間の温度インピーダンスの合計です。
- 標準特性図 1 ~ 6 は  $80\mu\text{s}$  パルス・デューティ比最大 0.5% 条件下で得られます。
- これらの値は  $T_a=25^\circ\text{C}$ 、2 オンス銅箔付き FR-4 基板上にマウントされた装置を使用して測定されています。SOA のグラフはパルス定格を規定しています。

# シングル N チャンネル MOSFET

ELM17408GA-S

<http://www.elm-tech.com>

## ■標準特性と熱特性曲線

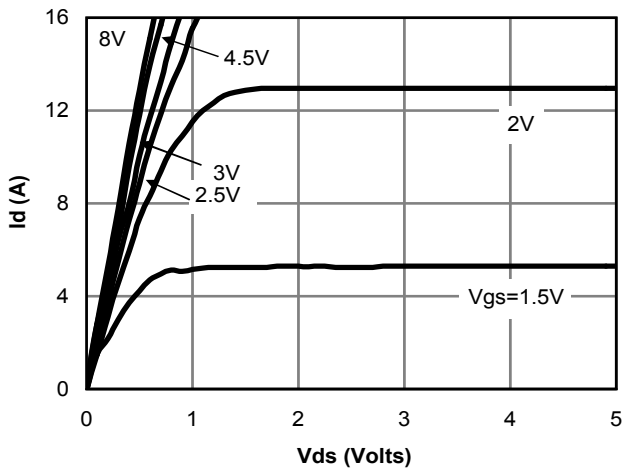


Fig 1: On-Region Characteristics

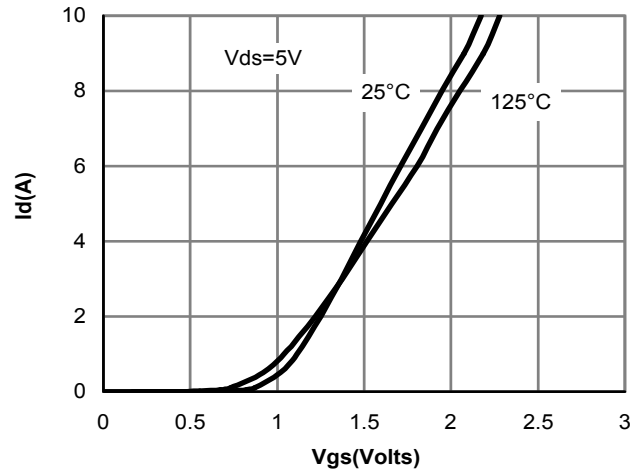


Figure 2: Transfer Characteristics

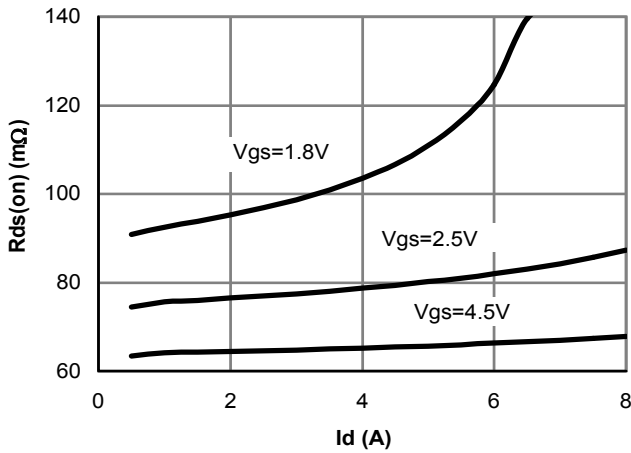


Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage

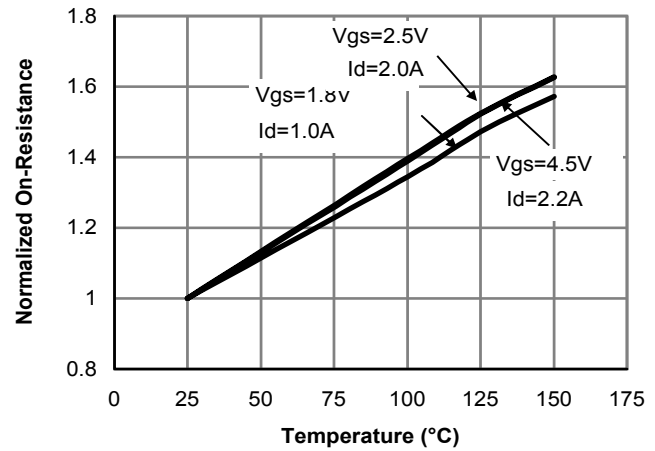


Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature

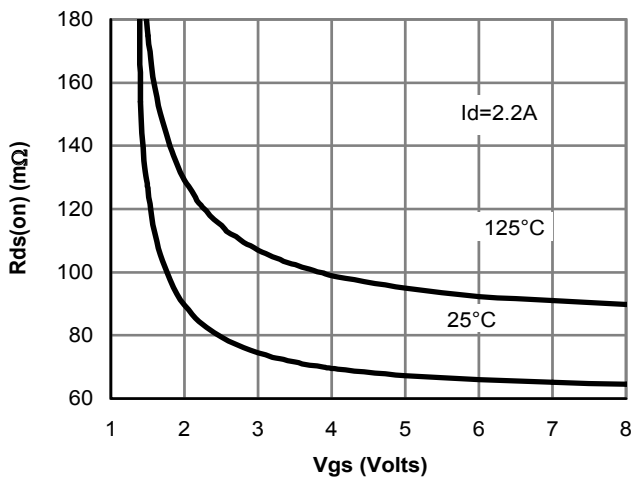


Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage

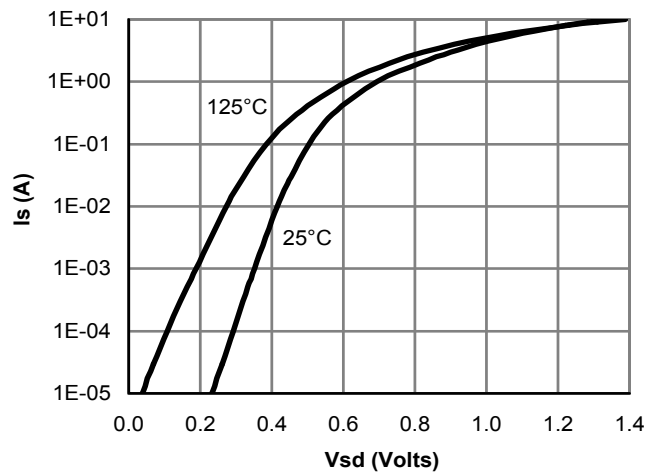


Figure 6: Body-Diode Characteristics

# シングル N チャンネル MOSFET

## ELM17408GA-S

<http://www.elm-tech.com>

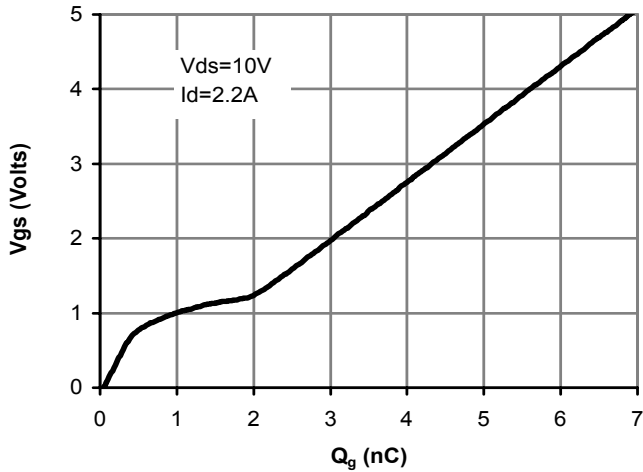


Figure 7: Gate-Charge Characteristics

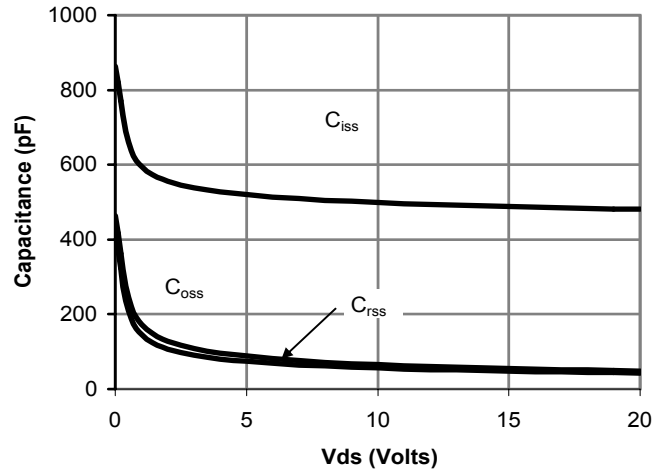


Figure 8: Capacitance Characteristics

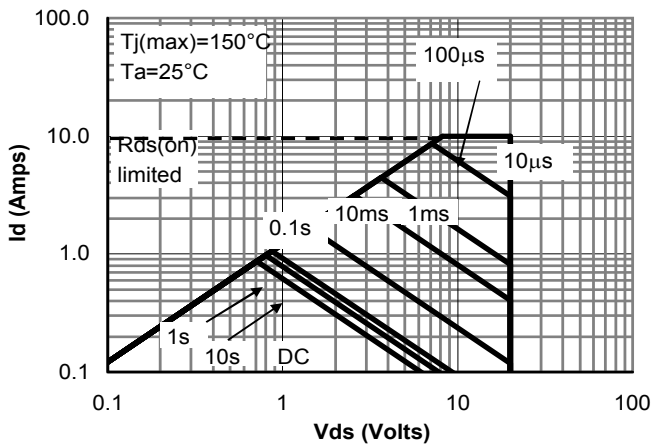


Figure 9: Maximum Forward Biased Safe Operating Area (Note 5)

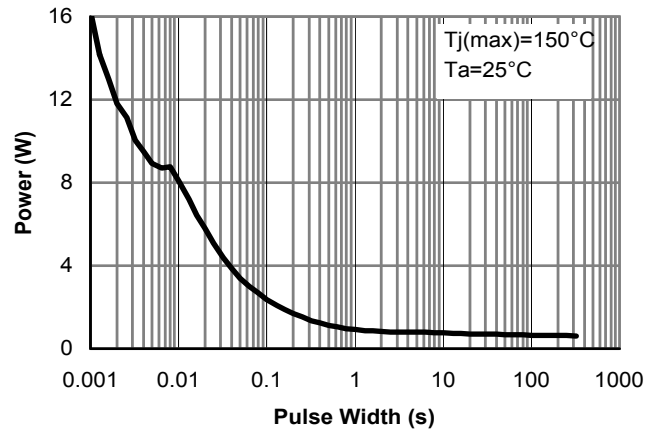


Figure 10: Single Pulse Power Rating Junction-to-Ambient (Note 5)

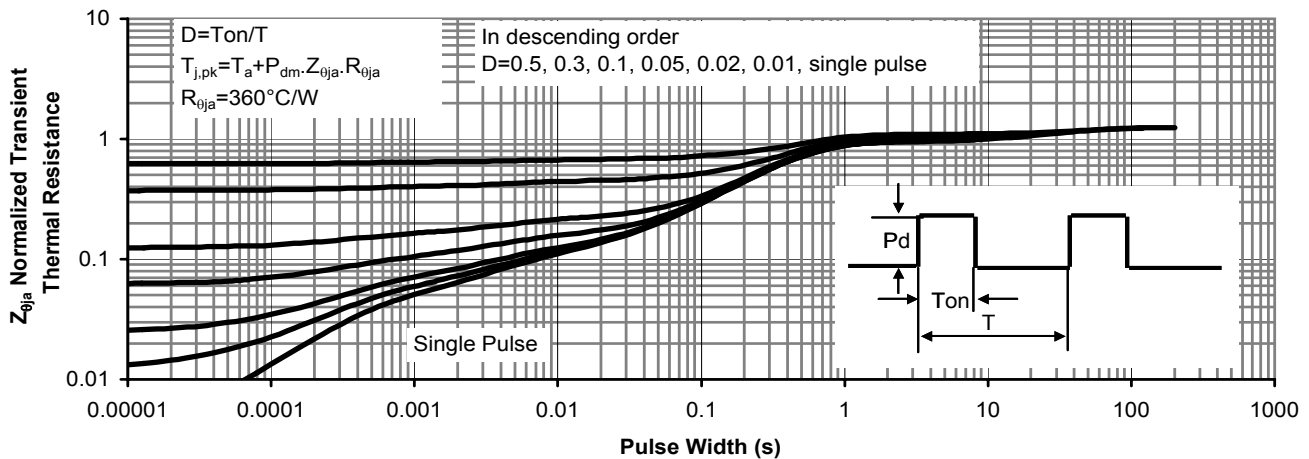


Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance